

ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ МОДУЛИ



Схема	Наим-е	Вход. напр-е макс., В	Вых. ток макс., А	Макс. имп.л. повтор. обр. напр-е, В	Макс. падение напр-я, В	при токе, А	Напр-е изоляции, В	Тип корпуса	
	B483C-2	240	35	600	1.25	35	2500	B-4T	
	B483F-2	480	35	1200	1.25	35	2500	B-4T	
	EFE13F	480	75/100	1200	1.85	75	2500	EF	
	M5060SB400	120	60	400	1.35	60	2500	M50D	
	M5060SB1000	380	60	1000	1.35	60	2500	M50D	
	M50100SB1000	380	100	1000	1.35	60	2500	M50D	
	M50100SB1600	600	100	1600	1.2	100	2500	M50D	
	M50100SB600	240	100	600	1.2	100	2500	M50D	
	B485E-2	380	50	1000	1.35	50	2500	B-4T	
	B485F-2	480	50	1200	1.35	50	2500	B-4T	
	EFG15G	530	125/170	1400	1.55	125	2500	EF	
	EFD15G	530	50/70	1400	1.7	50	2500	EF	
	EFF15F	480	100/135	1200	1.4	100	2500	EF	
	M5060TB1000	380	60	1000	1.35	60	2500	M50D	
	M5060TB600	240	60	600	1.35	60	2500	M50D	
	M50100TB1200	480	100	1200	1.2	100	2500	M50D	
	M50100TB1600	600	100	1600	1.2	100	2500	M50D	
		B512-2T	240	25	400	1.65	25	2500	B-2T
B512F-2		240	25	600	1.65	25	2500	B-2T	
EFD01FF		480	50/70	1200	1.7	50	2500	EF	
EFE01F		480	75/100	1200	1.85	75	2500	EF	
EFE01E		380	75/100	1000	1.85	75	2500	EF	
L512		240	25	600	2.2	15	2500	L	
L612F		240	42.5	600	1.6	42.5	2500	L	
L614		480	42.5	1200	1.6	42.5	2500	L	
M50100I2		240	100	600	1.4	100	2500	M50	
M5050I2		240	50	600	1.7	50	2500	M50	
M5050I2F		240	50	600	1.7	50	2500	M50	
M5050I4F		380	50	1000	1.7	50	2500	M50	
		EFD18E	380	50/70	1000	1.7	50	2500	EF
		EFE18F	380	75/100	1000	1.85	75	2500	EF
	EFE18G	530	75/100	1400	1.85	75	2500	EF	
	EFF18F	380	100/135	1000	1.4	100	2500	EF	
	EFG13F	480	125/170	1200	1.55	125	2500	EF	
	EFF18G	530	100/135	1400	1.4	100	2500	EF	
	EFG18F	480	125/170	1200	1.55	125	2500	EF	
	EFG18G	530	125/170	1400	1.55	125	2500	EF	
		EFD19G	530	50/70	1400	1.7	50	2500	EF
		EFF19GF	480	100/135	1200	1.4	100	2500	EF
EFE19G		530	75/100	1400	1.85	75	2500	EF	
	EFF05F	380	100/135	1000	1.4	100	2500	EF	
	EFF05G	530	100/135	1400	1.4	100	2500	EF	
	EFE05F	480	75/100	1200	1.85	75	2500	EF	
	EFE05G	530	75/100	1400	1.85	75	2500	EF	
	M505044	380	50	1000	1.7	50	2500	M50	
	M505045	480	50	1200	1.7	50	2500	M50	

Схема	Наим-е	Вход. напр-е макс., В	Вых. ток макс., А	Макс. импул. повтор. обр. напр-е, В	Макс. падение напр-я, В	при токе, А	Напр-е изоляции, В	Тип корпуса
	EFD16F	480	50/70	1200	1.7	50	2500	EF
	EFF16F	480	100/135	1200	1.4	100	2500	EF
	EFE04G	530	75/100	1200	1.85	75	2500	EF
	L542	240	25	600	2.2	15	2500	L
	M505032	240	50	600	1.7	50	2500	M50
	F1827SD1200	480	25	1200	1.55	75	2500	F18
	F1827SD600	240	25	600	1.55	75	2500	F18
	F1857SD1200	480	55	1200	1.4	165	2500	F18
	F1857SD1400	530	55	1400	1.4	165	2500	F18
	F1857CCD600	240	55	600	1.4	165	2500	F18
	L321F	120	15	400	2.2	15	2500	L
	M5060CC600	240	60	600	1.35	60	2500	M50D
	M50100DD1600	600	100	1600	1.2	100	2500	M50D
	M50100THA1600	600	100	1600	1.2	100	2500	M50D
	M50100THC1600	600	100	1600	1.2	100	2500	M50D
	M5010065V	480	100	1200	1.7	50	2500	M50
	M505065	480	50	1200	1.7	50	2500	M50
	M5010072	240	100	600	1.4	100	2500	M50
	M505053	280	50	800	1.7	50	2500	M50

Температурный диапазон: -40...125°C

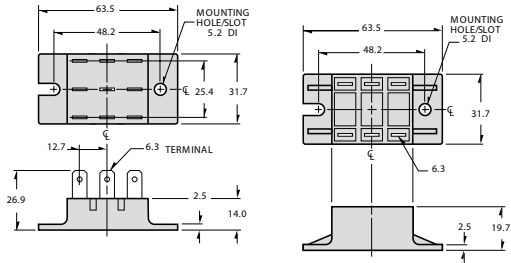
Последняя буква маркировки: F – диод, V – компонент защиты

ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ МОДУЛИ

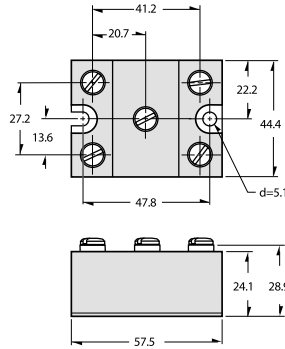


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

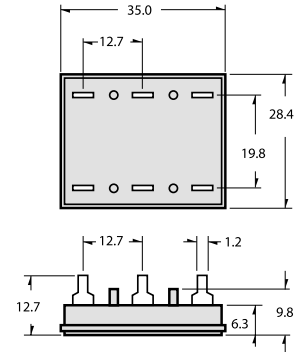
B-4T



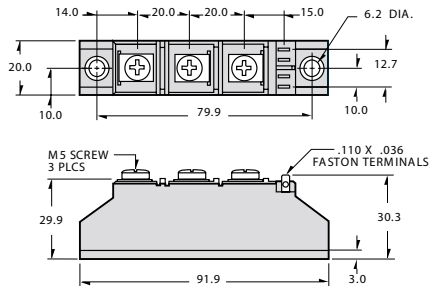
M50, M50D



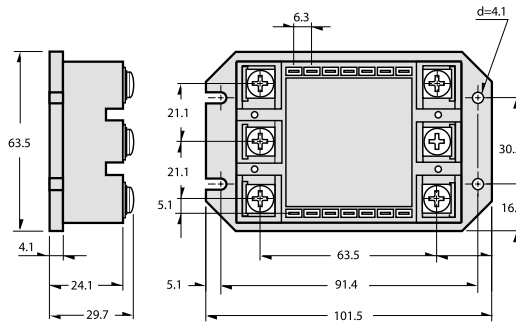
L



F18



EF



B-2T

